## КП784А

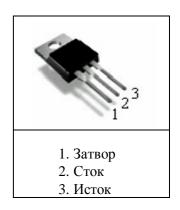
# МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Р-КАНАЛЬНЫЙ МОП ТРАНЗИСТОР

#### АДБК 432140.865 ТУ

- \* Зарубежный аналог **IRF9Z34**
- \* Изготавливается в корпусе КТ-28 (TO-220).

### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Един. измер.	Предельные значения
Напряжение сток-исток	<b>U</b> си max	В	-60
Напряжение затвор-исток	<b>U</b> зи max	В	±20
Постоянный ток стока	Ic max	A	-18
Импульсный ток стока	Іс и тах	A	-72
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	88
Прямой ток диода	Іпр. тах	A	-18
Температура перехода	Тпер	°C	175



## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°C)

Параметры	Обозначение	Ед.изме- рения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	<b>U</b> зи пор	В	Іс=-250мкА, Изи= Иси	-2.0	-4.0
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Rси отк	Ом	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ic=-11A,Uзи=-10B		0.14
Остаточный ток стока	Іс ост	мкА	Ucи=-60B,Uзи=0		-100
Ток утечки затвора	Із ут	нА	Uзи=±20В	-100	+100
Крутизна ВАХ	S	A/B	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ucu=-25B,Ic=-11A	5.9	
Прямое напряжение диода	Uпр	В	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ic=-18A, Uзи=0		-6.3
Входная емкость	* С <sub>11и</sub>	пФ	Uзи=0,Uси=-25В, f=1МГц		1540
Выходная емкость	* С <sub>22и</sub>	пΦ	Uзи=0,Uси=-25В, f=1МГц		660
Проходная емкость	* С <sub>12и</sub>	пФ	Uзи=0,Uси=-25В, f=1МГц		140

<sup>\*</sup> Справочные параметры

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор" Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: <a href="market@transistor.com.by">market@transistor.com.by</a> <a href="http://www.transistor.by">http://www.transistor.by</a>